る。）若しくはこれらの附属品若しくはこれらのために特に設計した部分品（ヌに該当するものを含む。）又はこれらの設計、製造若しくは使用に係る技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体

イ　録画用装置（第二条第五十五号に掲げるものを除く。）

ロ　画像処理装置

ハ　カメラ又は写真用機材

ニ　写真フィルム処理装置

ホ　イメージ増強装置

ヘ　赤外線暗視装置

ト　イメージングレーダーセンサー装置

チ　イからトまでに掲げるものの機能を妨げる装置及び当該装置の機能を妨げる装置

リ　次のいずれかに該当するものを組み込んだもの

（一）ヌ（二）に該当するイメージ増強管

（二）第四十五号ロに該当するフォーカルプレーンアレー

（三）第四十五号イに該当する固体の光検出器

ヌ　次のいずれかに該当するもの（二）に該当するもの以外のものについては、軍用に設計したものに限る。）

（一）赤外線画像変換管

（二）イメージ増強管であって、次のいずれかに該当するもの

1　次の一から三までのすべてに該当するもの

一　四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

二　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

(i)　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

(ii)　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの

三　次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの

(i)　主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が七〇〇マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの

(ii)　主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの

(iii)　主材料にⅢ－Ⅴ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。）を用いたものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの

2　次の一から三までのすべてに該当するもの

一　一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

二　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

(i)　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

(ii)　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの